Electron emissive ferroelectric cathode for an electron tube, flat display screen or particle accelerator has electrodes positioned to provide a main electric field line component parallel to the electron emissive surface

BV

Patent number:

FR2789223

Publication date:

2000-08-04

Inventor:

LE BIHAN RAYMOND

Applicant:

UNIV NANTES (FR)

Classification:

- international:

H01J29/04; H01J1/316

- european:

H01J1/30

Application number:

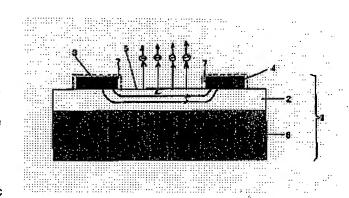
FR19990001008 19990129

Priority number(s):

FR19990001008 19990129

Abstract of FR2789223

Electron emissive cathode body (1) has electrodes (3, 4) positioned to provide a main electric field line component parallel to the electron emissive surface. An electron emissive cathode body (1) comprises a ferroelectric or anti-ferroelectric material layer (2) and electrodes (3, 4) which generate a variable electric field for exciting the layer, the electrodes being positioned in or on the layer such that the main component of the electric field lines (L) extends parallel to the electron emissive surface of the layer. Preferred Features: The ferroelectric or anti-ferroelectric layer (2) consists of an optionally doped material selected from lead titanate, leadlanthanum zirconate-titanate (PLZT), lead zirconate-titanate (PZT), barium titanate (BaTiO3), triglycine sulfate (TGS) and lithium niobate (LiNbO3).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11 Nº de publication :

2 789 223

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

②1 Nº d'enregistrement national :

99 01008

(51) Int Cl⁷: **H 01 J 29/04,** H 01 J 1/316

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- 22 Date de dépôt : 29.01.99.
- 30 Priorité :
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 04.08.00 Bulletin 00/31.
- Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

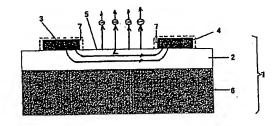
- \bigcirc Demandeur(s): $\mathit{UNIVERSITEDENANTES}$ FR.
- (72) Inventeur(s): LE BIHAN RAYMOND.
- 73 Titulaire(s) :
- Mandataire(s): LE BIHAN RAYMOND.

64 CORPS DE CATHODE FERROELECTRIQUE POUR LA PRODUCTION D'ELECTRONS.

L'invention concerne un corps (1) de cathode ferroélectrique pour l'émission d'électrons du type comprenant au moins une couche (2) émettrice d'électrons constituée d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et au moins deux électrodes (3, 4) alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche (2) émettrice.

Ce corps est caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) écartées l'une de l'autre sont positionnées dans ou sur la couche (2) ferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.

Application: écran plat - canon à électrons.





ı

10

20

Home and the state of the

REPORT OF THE PARTY OF THE PART

<u>Burgan</u>a kanada karangan baran B

15 <u>Corps de cathode ferroélectrique pour la production</u>
<u>d'électrons</u>

HOUSE BOOK INSTITUTE TO A STATE OF THE STATE

La présente invention concerne un corps de cathode ferroélectrique pour la production d'électrons.

Elle concerne plus particulièrement un corps de cathode ferroélectrique du type comprenant au moins une couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique émettrice d'électrons et au moins deux électrodes alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.

L'émission d'électrons à partir de la surface de cristaux ou de céramiques ferroélectriques soumis à des excitations répétitives avec des impulsions de tension est un phénomène connu. Sur la base de ce principe, des cathodes ferroélectriques ont été développées. Des exemples de ces cathodes ferroélectriques sont fournis notamment dans les documents FR-A-2.718.567 et FR-A-2.744.564. A ce jour, les corps de cathode sont tous conçus sur le même principe. En effet, ces corps de cathode comportent un substrat, une couche d'électrode inférieure formée sur un substrat ou

substrat, une constituant ce couche d'un ferroélectrique formée sur ladite couche d'électrode inférieure et une couche discontinue d'électrode supérieure formée sur ladite couche de matériau ferroélectrique, les vides de cette couche discontinue d'électrode supérieure constituant des passages des électrons émis par la couche ferroélectrique. Le principe de cette émission est lié au fait que, lorsqu'une impulsion de tension est appliquée électrodes supérieure et inférieure, 10 polarisation spontanée du matériau ferroélectrique est inversée sur la surface et à l'intérieur de la couche de cathode ferroélectrique et des électrons sont alors émis. De telles cathodes présentent un grand nombre d'avantages, à savoir notamment un rendement élevé d'électrons émis et 15 un maniement simple lié à leur robustesse et au fait qu'elles peuvent en particulier fonctionner à température Du fait de ces avantages, les cathodes ambiante. sont aujourd'hui ferroélectriques envisagées nombreux domaines d'application. Elles sont en particulier 20 utiles pour la réalisation de canons à électrons, de tubes à rayon cathodique, etc.

Toutefois, dans cette construction classique de cathodes, la couche en matériau ferroélectrique est toujours prise en sandwich entre deux couches d'électrode. Il résulte de cette construction de la cathode une évolution des domaines conforme au schéma représenté à la figure 1 dans lequel le domaine affecte une forme triangulaire. De ce fait, lorsque l'épaisseur de la couche ferroélectrique émissive, correspondant à l'inversion les barres distance entre polarisation, décroît. La constitutives de l'électrode supérieure doit alors diminuer si on souhaite obtenir une émission d'électrons sur la plus la surface de ladite de partie ferroélectrique et conserver des surfaces utiles d'émission de grande dimension. Cette obligation de rapprocher les électrodes engendre une augmentation du nombre d'électrodes et une diminution correspondante de la surface émettrice

d'électrons. De plus, le phénomène d'attraction des électrons par l'électrode supérieure prend plus d'importance et le rendement d'émission diminue. On sait par ailleurs que la tension de commande diminue lorsque 1'épaisseur de la couche ferroélectrique diminue.

Le but de la présente invention est donc de proposer un corps de cathode ferroélectrique dont la conception permet de réduire l'épaisseur de la couche ferroélectrique ou antiferroélectrique, sans avoir à augmenter outre mesure le nombre d'électrodes et à réduire les surfaces utiles d'émission, de telle sorte que le rendement d'émission d'électrons de la cathode est amélioré.

- Un autre but de la présente invention est de proposer un corps de cathode ferroélectrique ayant une épaisseur de couche ferroélectrique réduite de telle sorte que la tension appliquée peut être diminuée.
- A cet effet, l'invention a pour objet un corps de cathode 20 l'émission d'électrons, ferroélectrique pour couche émettrice d'électrons au moins une comprenant d'au moins un matériau ferroélectrique constituée antiferroélectrique et au moins deux électrodes alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour ferroélectrique matériau exciter la couche en antiferroélectrique, caractérisé en ce que les électrodes écartées l'une de l'autre sont positionnées dans, ou sur, ferroélectrique matériau couche antiferroélectrique de sorte que la composante principale électrique généré par champ đu électrodes s'étend sensiblement parallèlement à la surface d'électrons de matériau la couche en émettrice ferroélectrique ou antiferroélectrique.
- Grâce à cette conception du corps de cathode et en particulier grâce à l'arrangement des électrodes, l'épaisseur de la couche en matériau ferroélectrique ou

antiferroélectrique devient indépendante de la distance entre deux électrodes de sorte que l'épaisseur de cette couche peut être réduite sans avoir à augmenter le nombre d'électrodes et donc à rapprocher ces dernières de telle sorte que les phénomènes de bord seraient accentués, générant alors des effets parasites de bord tels que des décharges entre les bords d'électrodes.

L'invention sera bien comprise à la lecture de la 10 description suivante d'exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

> la figure 1 représente une vue schématique en coupe d'un corps de cathode conçu conformément à l'état de la technique;

> les figures 2 et 3 représentent à chaque fois une vue schématique en coupe d'un exemple de réalisation d'un corps de cathode conforme à l'invention;

> la figure 4 représente une vue schématique de dessus d'un corps de cathode conforme à l'invention et

la figure 5 représente une vue schématique de dessus de micro-cathodes conformes à l'invention en vue de la réalisation d'un écran plat.

Comme le montre la figure 1, un corps de cathode conforme à l'état de la technique est constitué d'une électrode inférieure représentée en 1' à la figure 1, d'une couche en matériau ferroélectrique représentée en 2' et d'une électrode supérieure représentée en 3', l'ensemble étant disposé à l'état superposé comme le montre la figure 1 de telle sorte que les domaines inversés sont conformes ou similaires à ceux représentés à la figure 1.

A l'inverse, le corps de cathode, objet de l'invention et représenté par la référence générale 1 aux figures 2 et 3,

15

20

est constitué d'un substrat isolant 6 réalisé en couche 2 en d'une matériau, diélectrique, matériau ou antiferroélectrique, éventuellement ferroélectrique dopé, formée sur ledit substrat 6 et d'un arrangement 5 d'électrodes 3, 4 disposées dans ou sur ladite couche 2 du ferroélectrique que de sorte la composante principale des lignes L du champ électrique généré par lesdites électrodes 3, 4 s'étend sensiblement parallèlement et non plus perpendiculairement à la surface émettrice 5 d'électrons de la couche 2 en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique. Cette modification de la disposition des électrodes permet de s'affranchir en ce qui concerne la disposition des électrodes 3 et 4 de l'épaisseur de la ferroélectrique . 2 en matériau couche 15 antiferroélectrique. Il devient ainsi possible de réaliser des corps de cathode avec des épaisseurs de couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique encore plus faibles que celles obtenues jusqu'à présent. Ainsi, de couche 2 matériau l'épaisseur de la en préférence, ferroélectrique ou antiferroélectrique est comprise dans la plage de 10 nm à 2 mm.

Malgré cette modification de la disposition des électrodes, la conception même de ce corps de cathode reste traditionnelle. Le substrat isolant peut ainsi être constitué d'un matériau choisi dans le groupe des composés constitués par MgO, SiO₂, Si₃N₄, le verre, les polymères, etc.

30 Il est à noter que ce substrat peut être également réalisé au moyen d'un fluide gazeux tel que de l'air.

La couche de matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique peut être quant à elle constituée d'au moins un matériau, dopé ou non, choisi dans le groupe des composés constitués par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb-lanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), le titanate de baryum (BaTiO₃), le TGS

(triglycine sulfate), le LiNbO₃, ainsi que de matériaux antiferroélectriques, dopés ou non. Ainsi, une couche mince ou épaisse de PZT ou de PLZT peut être obtenue par la méthode sol gel bien connue à ceux versés dans cet art.

5

Le dépôt de cette couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique sur le substrat peut également s'effectuer par d'autres techniques bien connues à ceux versés dans cet art. Ainsi, l'application de cette couche ferroélectrique peut s'effectuer par laminage mécanique ou par enduction avec une épaisseur définie comme le décrit le document FR-A-2.718.567. Il peut être également utilisé des procédés d'impression pour le dépôt de cette couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique sur le substrat.

D'autres méthodes généralement plus coûteuses que procédés de couche mince classiques peuvent être également utilisées. Il s'agit en particulier de la vaporisation ou 20 de l'application par pulvérisation ou par CVD (dépôt en phase gazeuse par procédé chimique). L'application de la peut encore s'effectuer ferroélectrique couche isolant substrat dans un mélange immersion du ferroélectrique liquide.

25

Indépendamment de la méthode choisie, une fois la couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique réalisée, l'arrangement d'électrodes 3, 4 peut alors être disposé à la surface de ladite couche. La fixation des électrodes 3 et 4 sur la couche ferroélectrique peut s'effectuer à nouveau par vaporisation à travers des masques adaptés à la forme de chaque électrode. L'avantage de cette mise en oeuvre consiste dans les faibles sollicitations mécaniques et thermiques de la couche ferroélectrique. Dans ce cas, les électrodes 3, 4 recouvrent partiellement la couche 2 de manière à former des portions d'électrode et des zones libres à travers lesquelles les électrons sont émis par la couche 2. Ces portions d'électrodes peuvent ainsi être

disposées en saillie (figure 2), en affleurement (figure 3) ou en retrait de la surface de la couche 2 ferroélectrique ou antiferroélectrique.

Cette fixation des électrodes peut encore s'effectuer par sérigraphie ou par photolithographie, technique utilisée en particulier en micro-électronique. L'arrangement d'électrodes 3, 4, quand il est disposé dans la couche ferroélectrique, doit conserver une orientation des lignes L de champ conforme à celle mentionnée ci-dessus.

Les électrodes peuvent également être disposées à même le substrat 6 comme schématisé sur la figure 3, la couche 2 étant dans ce cas réalisée après réalisation de ces électrodes.

15

25

30

35

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention conforme à la figure 2, au moins les bords des électrodes 3, 4 correspondant au bord d'une portion d'électrode entre portion d'électrode et zone libre peuvent être recouverts d'une couche 7 supplémentaire en un matériau diélectrique, en un matériau ferroélectrique ou en un matériau bords des Ce recouvrement des antiferroélectrique. par cette couche en matériau 3, électrodes antiferroélectrique ou diélectrique ferroélectrique ou permet d'éviter des effets parasites de bord tels que des décharges entre les bords d'électrodes. Cette configuration limite également l'attraction des électrons par lesdites électrodes.

Bien évidemment, la disposition relative des électrodes par rapport à la couche 2 peut varier sous réserve de conserver des lignes de champ conformes aux figures 2 et 3, c'est-àdire sensiblement parallèles à la surface émettrice 5 de la couche 2.

Les électrodes 3, 4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Ces électrodes 3, 4 peuvent être réalisées sous

d'éléments pleins ou ajourés. Dans un mode réalisation préféré, conforme à celui représenté à figure 4, les électrodes 3, 4 sont des électrodes dites interdigitales. Ces électrodes affectent la doigts, des doigts de l'une des électrodes s'étendant dans interdigital de l'autre électrode. réalisation des électrodes se caractérise par son faible encombrement. Ces électrodes peuvent être réalisées en des et variés. A titre d'exemple, divers matériaux 10 électrodes peuvent être réalisées en aluminium, or, platine ou en des matériaux non métalliques par exemples oxydes.

le corps de cathode coopère avec Généralement, 15 collecteur d'électrons qui peut être constitué par dite de réception telle qu'une anode. électrode collecteur d'électrons est disposé face à la surface couche 2, c'est-à-dire de la émettrice 5 l'arrangement d'électrodes 3, 4. Grâce à la présence de 20 cette électrode de réception, le circuit émetteur est fermé électriquement. Cette électrode de réception est séparée de l'arrangement d'électrodes 3, 4 par un volume dans lequel volume peut électrons. Ce émet des la cathode avantageusement contenir un vide poussé, du gaz ou du 25 plasma. Cette électrode de réception peut également être au contact du corps de cathode décrit ci-dessus, ceci étant intéressant dans le cas d'écrans particulièrement visualisation.

30 Le corps de cathode peut également coopérer avec un dispositif d'optique électronique pour constituer un canon à électrons applicable dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans plats ou d'accélérateurs de particules.

Le ou les générateurs de signaux électriques alimentant les électrodes 3, 4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Quand des puissances d'impulsion d'excitation très élevées

doivent être fournies, il peut être préférable de monter les générateurs d'impulsion en parallèle, chaque générateur ayant une impédance basse. De tels montages sont toutefois bien connus à ceux versés dans cet art.

5

Dans le cas où le corps de cathode est utilisé pour des réalisations spéciales comme par exemple des écrans plats, on a un ensemble de micro-sources d'électrons réalisées chacune comme indiqué ci-dessus. Ces micro-cathodes sont organisées en lignes et colonnes. Les cathodes d'une ligne ou respectivement d'une colonne sont reliées électriquement entre elles de manière à pouvoir commander séparément chaque micro-cathode. Une telle connexion est représentée à la figure 5.

15

Bien évidemment, les applications citées ci-dessus ne constituent en aucun cas une limitation de l'invention. Il est à noter par ailleurs que le terme ferroélectrique employé pour désigner la cathode doit être entendu dans son sens le plus général et inclut aussi bien les cathodes en matériau ferroélectrique que les cathodes en matériau antiferroélectrique, que ces matériaux soient ou non dopés.

REVENDICATIONS

- 1. Corps (1) de cathode ferroélectrique pour l'émission d'électrons, du type comprenant au moins une couche (2) émettrice d'électrons constituée d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et au moins deux électrodes (3, 4) alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique,
- caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) écartées l'une de l'autre sont positionnées dans, ou sur, la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes (L) du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.
- 2. Corps (1) de cathode selon la revendication 1, 20 caractérisé en ce qu'il est constitué d'un substrat isolant (6) réalisé en un matériau diélectrique, d'une couche (2) d'au moins un matériau ferroélectrique antiferroélectrique formée sur ledit substrat (6) et d'un arrangement d'électrodes (3, 4) disposées dans ou 25 ladite couche (2) du matériau ferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes (L) du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la ferroélectrique matériau couche (2) en 30 antiferroélectrique.
 - 3. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) sont des électrodes interdigitales.
 - 4. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) recouvrent partiellement la couche ferroélectrique (2) de manière à

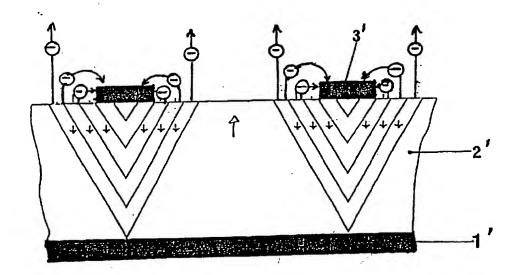
former des portions d'électrode et des zones libres à travers lesquelles sont émis les électrons produits par la couche (2) ferroélectrique ou antiferroélectrique.

5 5. Corps de cathode selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'au moins les bords des électrodes (3, 4) sont recouverts d'une couche (7) supplémentaire en un matériau diélectrique ou en un matériau ferroélectrique ou en un matériau antiferroélectrique.

- 6. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche de matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique est constituée d'au moins un matériau, dopé ou non, choisi dans le groupe des composés constitués par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb-lanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), le titanate de baryum (BaTiO₃), le TGS (triglycine sulfate), le LiNbO₃.
- 7. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'épaisseur de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique est comprise dans la plage de 10 nanomètres à 2 millimètres.
- 25 8. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 7, coopère avec un collecteur qu'il caractérisé en ce d'électrons tel qu'une électrode dite de réception, pour former un écran plat ou avec un dispositif d'optique canon à électrons un constituer électronique pour applicable dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans plats ou d'accélérateurs de particules.

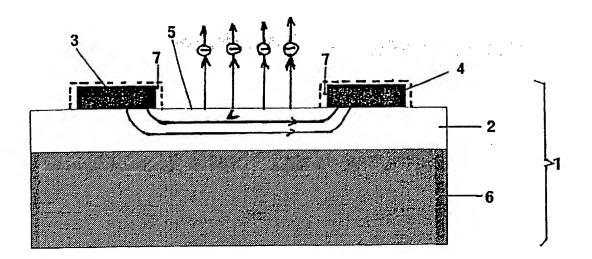
1/5

FIGURE 1



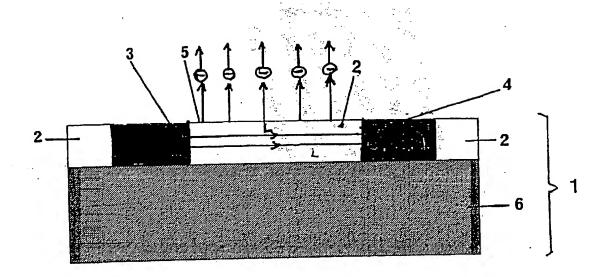
2/5

FIGURE 2



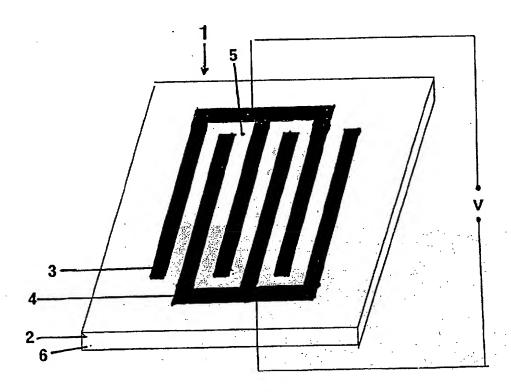
3/5

FIGURE 3



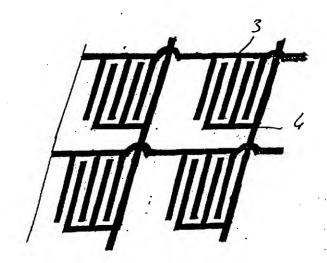
4/5

FIGURE 4



·5/5

FIGURE 5



REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement national

FA 575532 FR 9901008

Citation du document avec indication, en cass des parties pertinentes 5 453 661 A (MCGUIRE GA septembre 1995 (1995-09 colonne 9, ligne 29 - colonne 19 - c	RY E ET A -26) lonne 10, lgure 5 * KARL OTTO 3) ENT TREUHA	L) 1 ligne 1 ligne 1	,2,6-8	DOMAINES TECH	
septembre 1995 (1995-09 colonne 9, ligne 29 - co ; revendications 1-31; f	-26) lonne 10, lgure 5 * KARL OTTO 3) ENT TREUHA	ligne) 1 ND) 1	,6	DOMAINES TECH	
3 octobre 1995 (1995-10-1 revendication 10 *	3) ENT TREUHA 3) SHI ELECTRI	IND) 1	l ,6	DOMAINES TECH	
3 juin 1998 (1998-06-18) revendications 1-8 *	S) SHI ELECTRI			DOMAINES TECH	
9 mai 1991 (1991-05-29) revendication 1 * ATENT ABSTRACTS OF JAPAN ol. 1997, no. 03, 1 mars 1997 (1997-03-31) JP 08 293272 A (MITSUBIS DRP), 5 novembre 1996 (19 abrégé *	SHI ELECTRI		l [,5	DOMAINES TECH	
ol. 1997, no. 03, 1 mars 1997 (1997-03-31) JP 08 293272 A (MITSUBIS DRP), 5 novembre 1996 (19 abrégé *	SHI ELECTRI 996-11-05)		1,5	DOMAINES TECH	
		.		HO1J	INIQUES (Int.CL.6)
ATENT ABSTRACTS OF JAPAN ol. 1998, no. 05, 0 avril 1998 (1998-04-30 JP 10 027539 A (SHARP CO 7 janvier 1998 (1998-01-) abrégé *	ORP),	-	1,5		
Dat				Examinateur	<u></u>
	19 octobr				e, E
			- blabasadó		
	Dat	19 octobr	Date d'achèvement de la recherche 19 octobre 1999 GORIE DES DOCUMENTS CITES T: théorie ou principe	19 octobre 1999 Va	Date discribing do in 100 Maria

1

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR ENHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
☐ OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.